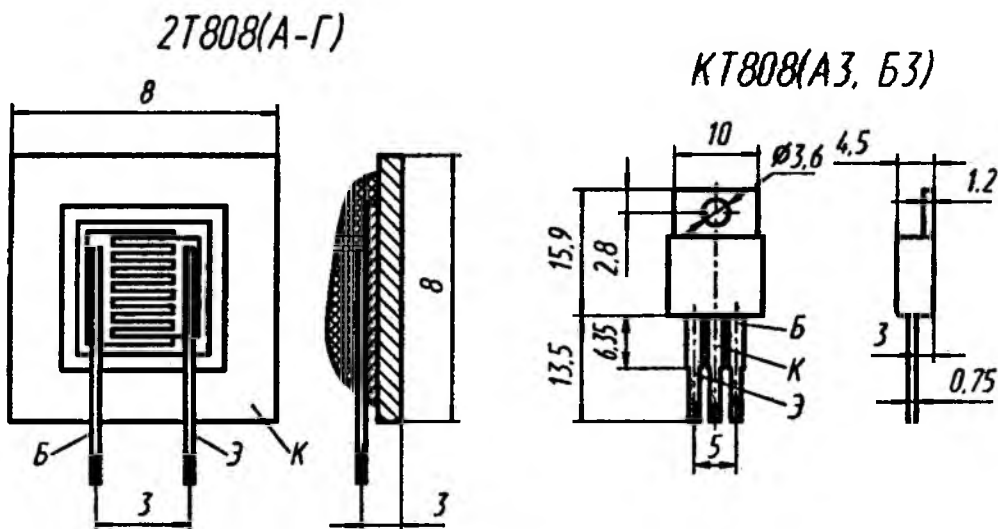


**2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808АМ, КТ808БМ,  
КТ808ВМ, КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3**

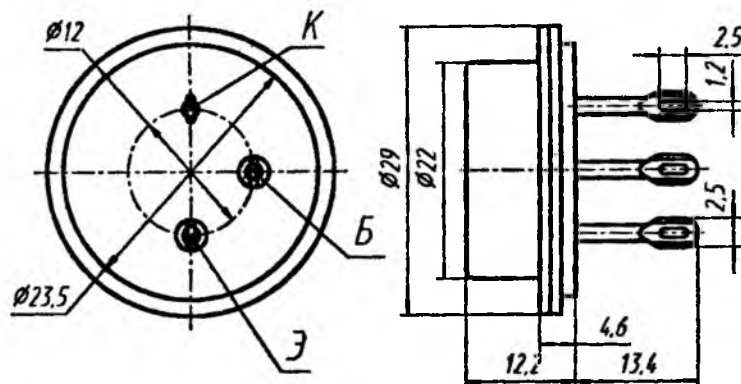
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ-КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами, КТ808А3, КТ808Б3 — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ-КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г, КТ808А3, КТ808Б3 — не более 2,5 г.

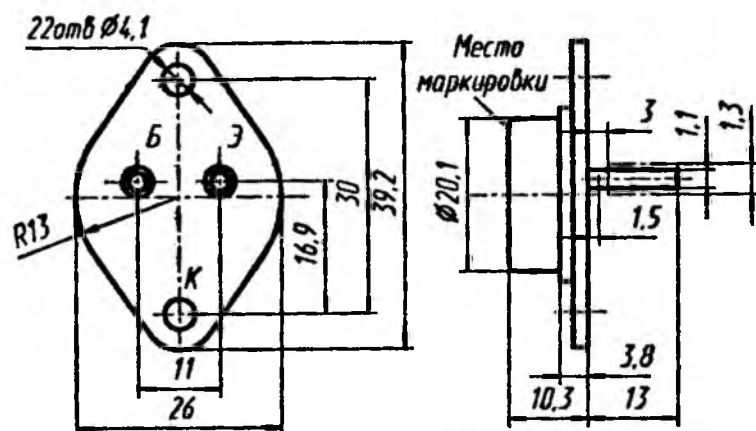
Изготовитель — завод «Искра», г. Ульяновск.



2Т808А, КТ808А



## КТ808(АМ-ГМ)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при  $U_{кэ} = 3$  В,

$I_k = 6$  А:

$T = +25$  °С ..... 10...15\*...50

$T = +125$  °С для 2Т808А и  $T = +100$  °С  
для КТ808А .....

10...20\*...150

$T = -60$  °С .....

6...10\*...50

КТ808АМ-КТ808ГМ, КТ808А3, КТ808Б3

при  $U_{кэ} = 3$  В,  $I_k = 2$  А .....

20...125

Модуль коэффициента передачи тока на вы-  
сокой частоте  $f = 3,5$  МГц при  $U_{кэ} = 10$  В,

$I_b = 0,5$  А, не менее .....

2,4

Граничное напряжение при  $I_k = 0,1$  А,

$L = 25$  мГн, не менее:

КТ808АМ, КТ808А3 .....

130 В

КТ808БМ, КТ808Б3 .....

100 В

КТ808ВМ .....

80 В

КТ808ГМ .....

70 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

КТ808АМ-КТ808ГМ при  $I_k = 6$  А,  $I_b = 0,6$  А,  
не более .....

1,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер

при  $I_k = 6$  А,  $I_b = 0,6$  А .....

1\*...1,4\*...

2,5 В

Время рассасывания при  $U_{кэ} = 15$  В,  $I_k = 6$  А,

не более .....

2 мкс

Обратный ток коллектор-эмиттер

при  $R_{бэ} = 10$  Ом, не более:

$T = +25$  и  $-60$  °С и  $U_{кэ} = 200$  В для

2Т808А, 2Т808А-2 и  $U_{кэ} = 120$  В для

КТ808А .....

3 мА

$T = +125$  °С,  $U_{кэ} = 160$  В для 2Т808А,

2Т808А-2 .....

20 мА

$T = +100$  °С  $U_{кэ} = 120$  В для КТ808А .....

50 мА

Обратный ток коллектора $I_{CO8AM-KT808GM}$ , KT808A3, KT808B3 при $U_{KЭ} = U_{KЭ R, MAX}$ , $T = +25$ °C, не более .....	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В, не более .....	15 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 1$ МГц, не более .....	500 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер <sup>1</sup> при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $T_n \leq 100$ °C	
2Т808А, 2Т808А–2, КТ808А .....	120 В
КТ808АМ, КТ808АЗ .....	130 В
КТ808БМ, КТ808БЗ .....	100 В
КТ808ВМ .....	80 В
КТ808ГМ .....	70 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер <sup>1</sup> при $t_n \leq 500$ мкс, $t_{Ф} \geq 30$ мкс, $U_{БЭ} = 2$ В или $R_{БЭ} = 10$ Ом, $Q \geq 7$ , $T_n \leq +100$ °C:	
2Т808А, 2Т808А–2, КТ808А, КТ808АМ .....	250 В
КТ808БМ .....	160 В
КТ808ВМ .....	135 В
КТ808ГМ .....	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
2Т808А, 2Т808А–2, КТ808А .....	4 В
КТ808АМ–КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	10 А
Импульсный ток коллектора .....	15 А

<sup>1</sup> При  $T_n = +100...150$  °C постоянное и импульсное напряжение коллектор—эмиттер снижаются на 10% на каждые 10 °C. Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_n + R_{T(n-K)}(P_K + P_Э), \text{ °C.}$$

Постоянный ток базы .....	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+50$ °C:	
с теплоотводом:	
2Т808А, 2Т808А–2, КТ808А .....	50 Вт
КТ808АМ–КТ808ГМ, КТ808АЗ, КТ808БЗ .....	70 Вт
без теплоотвода 2Т808А, КТ808А .....	5 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус .....	2 °C/Вт
Температура р-п перехода .....	+150 °C
Температура окружающей среды:	
2Т808А, 2Т808А–2, КТ808АМ–КТ808ГМ ...	$-60...T_K =$ $= +125$ °C
КТ808А, КТ808АЗ, КТ808БЗ .....	$-60...T_K =$ $= +100$ °C

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А–2 не более +250 °C, 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ–КТ808ГМ не более +275 °C в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А–2 составляет 300 В.